

(12) 特許協力条約に基づいて公開された国際出願

(19) 世界知的所有権機関
国際事務局

(43) 国際公開日
2014 年 8 月 7 日(07.08.2014)



(10) 国際公開番号

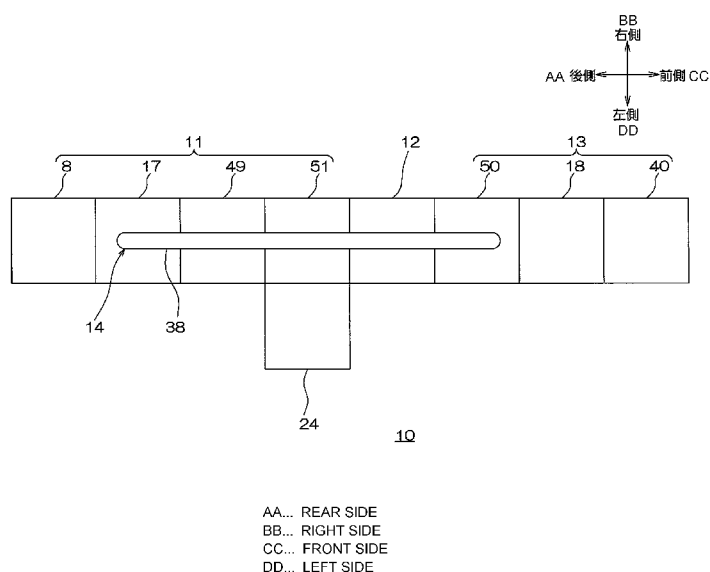
WO 2014/119446 A1

- (51) 国際特許分類:
H01L 21/56 (2006.01)
- (21) 国際出願番号: PCT/JP2014/051233
- (22) 国際出願日: 2014 年 1 月 22 日(22.01.2014)
- (25) 国際出願の言語: 日本語
- (26) 国際公開の言語: 日本語
- (30) 優先権データ:
特願 2013-014667 2013 年 1 月 29 日(29.01.2013) JP
特願 2013-053627 2013 年 3 月 15 日(15.03.2013) JP
- (71) 出願人: 日東電工株式会社(NITTO DENKO CORPORATION) [JP/JP]; 〒5678680 大阪府茨木市下穂積 1 丁目 1 番 2 号 Osaka (JP).
- (72) 発明者: 松下 孝夫(MATSUSHITA, Takao); 〒5190193 三重県亀山市布気町 919 番地 日東精機株式会社内 Mie (JP). 森 伸一郎(MORI, Shinichiro); 〒5190193 三重県亀山市布気町 919 番地 日東精機株式会社内 Mie (JP).
- (74) 代理人: 岡本 寛之, 外(OKAMOTO, Hiroyuki et al.); 〒5320003 大阪府大阪市淀川区宮原 4 丁目 5 番 3 6 号 セントラル新大阪ビル 3 F いくみ特許事務所内 Osaka (JP).
- (81) 指定国 (表示のない限り、全ての種類の国内保護が可能): AE, AG, AL, AM, AO, AT, AU, AZ, BA, BB, BG, BH, BN, BR, BW, BY, BZ, CA, CH, CL, CN, CO, CR, CU, CZ, DE, DK, DM, DO, DZ, EC, EE, EG, ES, FI, GB, GD, GE, GH, GM, GT, HN, HR, HU, ID, IL, IN, IR, IS, KE, KG, KN, KP, KR, KZ, LA, LC, LK, LR, LS, LT, LU, LY, MA, MD, ME, MG, MK, MN, MW, MX, MY, MZ, NA, NG, NI, NO, NZ, OM, PA, PE, PG, PH, PL, PT, QA, RO, RS, RU, RW, SA, SC, SD, SE, SG, SK, SL, SM, ST, SV, SY, TH, TJ, TM, TN, TR, TT, TZ, UA, UG, US, UZ, VC, VN, ZA, ZM, ZW.
- (84) 指定国 (表示のない限り、全ての種類の広域保護が可能): ARIPO (BW, GH, GM, KE, LR, LS, MW, MZ, NA, RW, SD, SL, SZ, TZ, UG, ZM, ZW), ユーラシア (AM, AZ, BY, KG, KZ, RU, TJ, TM), ヨーロッパ (AL, AT, BE, BG, CH, CY, CZ, DE, DK, EE, ES, FI, FR, GB, GR, HR, HU, IE, IS, IT, LT, LU, LV, MC, MK, MT, NL, NO, PL, PT, RO, RS, SE, SI, SK, SM, TR), OAPI (BF, BJ, CF, CG, CI, CM, GA, GN, GQ, GW, KM, ML, MR, NE, SN, TD, TG).
- 添付公開書類:
— 国際調査報告 (条約第 21 条(3))

(54) Title: PRODUCTION METHOD AND PRODUCTION DEVICE FOR SEMICONDUCTOR DEVICES

(54) 発明の名称: 半導体装置の製造方法および製造装置

[図1]



(57) Abstract: This method is a production method for semiconductor devices obtained by sealing a semiconductor element, by using a sealing sheet. The production method for semiconductor devices comprises: a preparation step in which the sealing sheet and the semiconductor element are prepared; a sealing step in which, after the preparation step, the semiconductor element is sealed using the sealing sheet; and a recovery step in which, after the sealing step, the sealing sheet and the semiconductor element are recovered. The sealing step comprises an excess-portion generating step in which an excess portion of the sealing sheet is generated while the sealing sheet is being pressed by two press members arranged facing each other and sandwiching the sealing sheet therebetween. The recovery step comprises a removal step in which the excess portion is removed.

(57) 要約: この方法は、封止シートによって半導体素子を封止することにより得られる半導体装置の製造方法である。半導体装置の製造方法は、封止シートおよび半導体素子を準備する準備工程、準備工程の後に、封止シート

によって半導体素子を封止する封止工程、および、封止工程の後に、封止シートおよび半導体素子を回収する回収工程を備える。封止工程は、封止シートを、封止シートを挟んで互いに対向配置される2つのプレス部材によってプレスしながら、封止シートの余剰部分を発生させる余剰部分発生工程を備える。回収工程は、余剰部分を除去する除去工程を備える。

WO 2014/119446 A1